



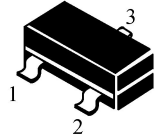
桂林斯壯微電子有限責任公司

Guilin Strong Micro-Electronics Co.,Ltd.

GMM28S

SOT-23

- 1. BASE
- 2. EMITTER
- 3. COLLECTOR



■FEATURES 特點

High h_{FE} 高放大倍數
NPN silicon NPN 硅管

■MAXIMUM RATINGS 最大定額值($T_a=25^{\circ}C$)

CHARACTERISTIC 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Base Voltage 集電極-基極電壓	V_{CBO}	40	V
Collector-Emitter Voltage 集電極-發射極電壓	V_{CEO}	20	V
Emitter-Base Voltage 發射極-基極電壓	V_{EBO}	5	V
Collector Current-Pulse 集電極電流-脈沖	I_c	1000	mA
Collector Power Dissipation 集電極耗散功率	P_C	300	mW
Junction Temperature 結溫	T_j	150	$^{\circ}C$
Storage Temperature Range 儲存溫度	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}C$

■DEVICE MARKING 打標

GMM28S (M28S) =28S.



GMM28S

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Test Condition 測試條件	Min. 最小值	Typ. 典型值	Max. 最大值	Unit 單位
Collector Cutoff Current 集電極截止電流	I_{CBO}	$V_{CB}=25\text{V}, I_E=0$	—	—	100	nA
Emitter Cutoff Current 發射極截止電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5\text{V}, I_C=0$	—	—	100	nA
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=100\mu\text{A}$	40	—	—	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集電極-射極擊穿電壓	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=1\text{mA}$	20	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=100\mu\text{A}$	5	—	—	V
DC Current Gain 直流電流增益	h_{FE}	$V_{CE}=1\text{V},$ $I_C=100\text{mA}$	300	—	1200	—
Transition Frequency 特徵頻率	f_T	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=10\text{mA}$	—	120	—	MHz
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=600\text{mA},$ $I_B=20\text{mA}$	—	—	0.55	V
Base-Emitter Saturation Voltage 基極-發射極飽和壓降	$V_{BE(sat)}$	$I_C=600\text{mA},$ $I_B=20\text{mA}$	—	—	1.2	V